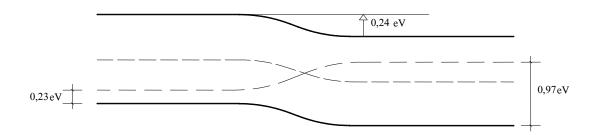
**ZEMRIS** 15.2.2016.

## 1. ISPITNI ROK IZ ELEKTRONIKE 1

**ZADATAK 1.** Energetski dijagram silicijske pn diode prikazan je na slici. Parametri manjinskih nosilaca su  $\mu_n = 850 \text{ cm}^2/\text{Vs}, \ \mu_p = 280 \text{ cm}^2/\text{Vs}, \ \tau_n = 0.5 \text{ µs}$  i  $\tau_p = 0.8 \text{ µs}$ . Širine strana iznose  $w_n = 2 \text{ µm}$  i  $w_p = 5 \text{ µm}$ , a površina pn spoja je  $S = 1 \text{ mm}^2$ . Pretpostaviti m = 1 i T = 300 K.



- a) Odrediti koncentracije većinskih nosilaca i kontaktni potencijal (2 boda).
- b) Odrediti ravnotežne i rubne koncentracije manjinskih nosilaca (3 boda).
- c) Izračunati struju koja protječe kroz diodu (2 boda).
- d) Skicirati raspodjele manjinskih nosilaca na *p* i *n* strani diode. Potrebno je označiti sve rubne i ravnotežne koncentracije (**3 boda**).

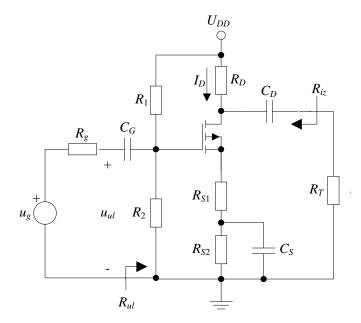
**ZADATAK 2.** Za silicijski MOSFET poznate su dvije točke (A i B) koje leže na istoj prijenosnoj karakteristici. Jedna od točaka nalazi se u triodnom području, a druga u području zasićenja. Poznati su slijedeći podaci:  $U_{GSA} = -0.5$  V,  $U_{DSA} = 1$  V,  $I_{DA} = 0.25$  mA,  $U_{GSB} = 2$  V,  $I_{DB} = 5$  mA. Zanemariti porast struje odvoda u području zasićenja ( $\lambda = 0$ ).

- a) Odrediti tip MOSFET-a (*n* ili *p*-kanalni, obogaćeni ili osiromašeni) i tip nosilaca u kanalu (**1,5 bod**).
- b) Odrediti područje rada tranzistora u točkama A i B (1 bod).
- c) Odrediti napon praga  $U_{GS0}$  i strujni koeficijent K (4 boda).
- d) Točka C leži na istoj izlaznoj karakteristici kao i točka B, te vrijedi  $U_{DSC} = 3$  V. Odrediti područje rada tranzistora i struju odvoda  $I_{DC}$  u točki C (1,5 bod).
- e) Debljina oksida MOS strukture iznosi  $t_{ox} = 15$  nm, pokretljivost nosilaca u kanalu je  $\mu = 300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ , a širina kanala iznosi 10  $\mu$ m. Odrediti duljinu kanala MOSFET-a (**2 boda**).

**ZEMRIS** 15.2.2016.

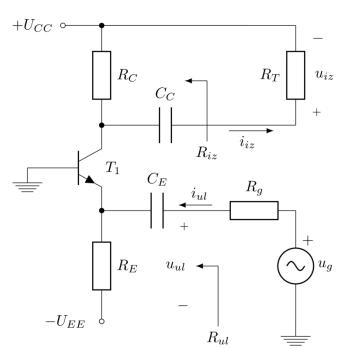
**ZADATAK 3.** Za pojačalo na slici zadano je:  $U_{DD} = -12$  V,  $R_g = 500$  Ω,  $R_1 = 4.3$  MΩ,  $R_2 = 2.2$  MΩ,  $R_D = 2$  kΩ,  $R_{S2} = 200$  Ω,  $R_T = 4.7$  kΩ. Parametri p-kanalnog MOSFET-a su: K = -2 mA/V<sup>2</sup>,  $U_{GS0} = -1.5$  V i  $\lambda = -0.0045$  V<sup>-1</sup>.

- a) Odrediti vrijednost otpornika  $R_{S1}$  takvu da napon  $U_{GSQ}$  iznosi -3 V. Izračunati  $I_{DQ}$ ,  $U_{DSQ}$  te strminu i dinamički otpor u statičkoj radnoj točki. Pri proračunu statičke radne točke zanemariti porast struje odvoda u području zasićenja (2 boda).
- b) Nacrtati nadomjesnu shemu za dinamičku analizu te izvesti izraz i izračunati naponsko pojačanje  $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ , strminsko pojačanje  $G_M = i_{iz}/u_{ul}$ , ulazni otpor  $R_{ul}$  te izlazni otpor  $R_{iz}$  (8 bodova).



**ZADATAK 4.** Za pojačalo na slici zadani su sljedeći podaci:  $U_{CC} = U_{EE} = 10 \text{ V}$ ,  $R_g = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 3.6 \text{ k}\Omega$  i  $R_T = 3 \text{ k}\Omega$ . Vrijedi:  $\beta \approx h_{fe} >> 1$ ,  $U_{\gamma} = 0.7 \text{ V}$ ,  $U_T = 25 \text{ mV}$ . Zanemariti porast struje kolektora u normalnom aktivnom području.

- a) Odredite statičku radnu točku  $(I_{CQ}, U_{CEQ})$  i izračunajte strminu  $g_m$  tranzistora  $T_1$  (2 boda).
- **b)** Nacrtajte nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku analizu (**2 boda**).
- c) Izvedite izraze i izračunajte naponsko pojačanje  $A_V = u_{iz}/u_{ul}$  i ulazni otpor  $R_{ul} = u_{ul}/i_{ul}$  (3 boda).
- **d)** Izvedite izraze i izračunajte naponsko pojačanje u odnosu na generator  $A_{Vg} = u_{iz}/u_g$ , strujno pojačanje  $A_I = i_{iz}/i_{ul}$  i izlazni otpor  $R_{iz} = u_{iz}/i_{iz}$  (3 boda).



**ZEMRIS** 15.2.2016.

**ZADATAK 5.** Za zadani sklop izračunati iznos napona  $u_{IZ}$  ako ulazni naponi iznose  $u_{UL1}=1$  V i  $u_{UL2}=2$  V. Otpornici su iznosa  $R_1=1$  kΩ,  $R_2=R_8=4.7$  kΩ,  $R_3=R_4=10$  kΩ,  $R_5=22$  kΩ,  $R_6=33$  kΩ i  $R_7=560$  Ω. Operacijska pojačala su idealna (**10 bodova**).

